

Silicon Diode

BAV19

120V / 250mA

DATASHEET

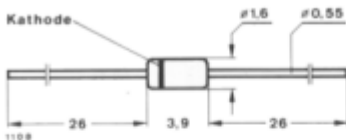
OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

BAV 17 bis BAV 21**Silizium-Epitaxial-Planar-Diode**

Anwendungen: Allgemein

Abmessungen in mm



Normgehäuse
54 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempfung: Klartext oder Farbcodierung nach Pro electron

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung

BAV 17	U_R	25	V
BAV 18	U_R	60	V
BAV 19	U_R	120	V
BAV 20	U_R	200	V
BAV 21	U_R	250	V

Durchlaßstrom

I_F	250	mA
-------	-----	----

Stoßdurchlaßstrom

 $t_p \leq 1 \text{ s}, T_j = 25 \text{ °C}$

I_{FSM}	1	A
-----------	---	---

Spitzendurchlaßstrom

 $f = 50 \text{ Hz}$

I_{FM}	625	mA
----------	-----	----

Sperrschichttemperatur

T_j	175	°C
-------	-----	----

Lagerungstemperaturbereich

T_{stg}	- 65...+ 175	°C
-----------	--------------	----

BAV 17 bis BAV 21

Wärmewiderstand		Min.	Typ.	Max.	
Sperrschichtumgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$				350	K/W
Kenngrößen					
$T_J = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 100 \text{ mA}$				1	V
Sperrstrom					
$U_R = 20 \text{ V}$	BAV 17	I_R		100	nA
$U_R = 50 \text{ V}$	BAV 18	I_R		100	nA
$U_R = 100 \text{ V}$	BAV 19	I_R		100	nA
$U_R = 150 \text{ V}$	BAV 20	I_R		100	nA
$U_R = 200 \text{ V}$	BAV 21	I_R		100	nA
$T_J = 150 \text{ °C}$					
$U_R = 20 \text{ V}$	BAV 17	I_R		15	μA
$U_R = 50 \text{ V}$	BAV 18	I_R		15	μA
$U_R = 100 \text{ V}$	BAV 19	I_R		15	μA
$U_R = 150 \text{ V}$	BAV 20	I_R		15	μA
$U_R = 200 \text{ V}$	BAV 21	I_R		15	μA
Durchbruchspannung $I_R = 100 \mu\text{A}$					
	BAV 17	$U_{(BR)}^{1)}$	25		V
	BAV 18	$U_{(BR)}^{1)}$	60		V
	BAV 19	$U_{(BR)}^{1)}$	120		V
	BAV 20	$U_{(BR)}^{1)}$	200		V
	BAV 21	$U_{(BR)}^{1)}$	250		V
Diodenkapazität $U_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$		C_D		1,5	pF
Differenzieller Durchlaßwiderstand $I_F = 10 \text{ mA}$		r_f		5	Ω
Rückwärtserholzeit $I_F = I_R = 30 \text{ mA}, I_R = 3 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$		t_{rr}		50	ns

¹⁾ $\frac{t_D}{T} = 0,01, t_p = 0,3 \text{ ms}$